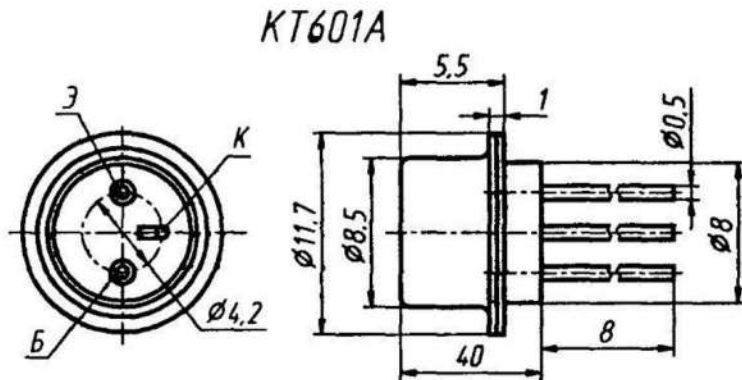


КТ601А, КТ601АМ

Транзисторы кремниевые диффузионные структуры *p-p-n* усилительные. Предназначены для применения в радиовещательных и телевизионных приемниках. Выпускаются в металлокерамическом (КТ601А) и в пластмассовом (КТ601АМ) корпусах с жесткими выводами. Тип прибора указывается на корпусе.

Масса КТ601А не более 2 г, КТ601АМ — не более 0,7 г.

Изготовитель — АОТ Воронежский завод полупроводниковых приборов, г. Воронеж.



Электрические параметры

Коэффициент передачи тока в режиме малого сигнала при $U_{КЭ} = 20$ В, $I_3 = 20$ мА, не менее:

$T = +25...+85$ °С 16

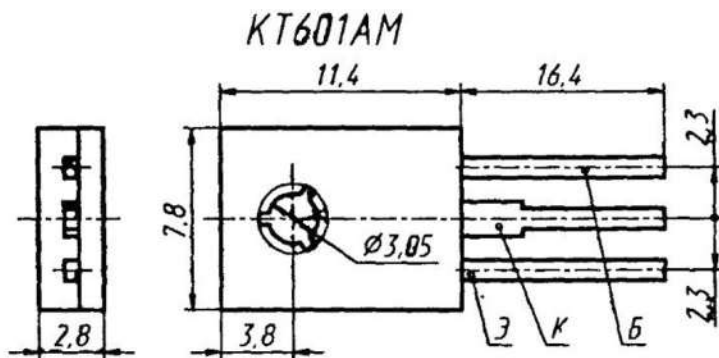
$T = -40$ °С 10

Граничная частота при $U_{КЭ} = 20$ В, $I_3 = 10$ мА, не менее 40 МГц

Постоянная времени цепи обратной связи
 $U_{КБ} = 50$ В, $I_3 = 6$ мА, $f = 2$ МГц, не более 15 пс

Емкость коллекторного перехода
при $U_{КБ0} = 20$ В, не более 15 пФ

Обратный ток коллектор—эмиттер
при $U_{КЭ} = 100$ В, $R_{БЭ} = 10$ кОм, не более 300 мкА



Обратный ток эмиттера при $U_{360} = 2$ В,
не более 100 мкА

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор—база	100 В
Постоянное напряжение коллектор—эмиттер при $R_{БЭ} = 10$ кОм	100 В
Постоянное напряжение эмиттер—база	2 В
Постоянный ток коллектора	30 мА
Постоянный ток базы	30 мА
Постоянная рассеиваемая мощность:	
без теплоотвода, $T = +55$ °С	
и $T_K = +75$ °С.....	250 мВт
с теплоотводом, $T_K = +55$ °С.....	500 мВт
Температура p - n перехода	+150 °С
Температура окружающей среды	-10...+85 °С

Изгиб выводов транзисторов КТ601А допускается не ближе 5 мм от корпуса с радиусом изгиба не менее 3 мм. При этом необходимо обеспечить неподвижность вывода между местом изгиба и стеклянным изолятором.

Изгиб выводов транзисторов КТ601АМ допускается под углом не более 90° в плоскости, перпендикулярной плоскости основания корпуса, и не ближе 3 мм от корпуса с радиусом изгиба не менее 1,5 мм.

Пайка выводов транзисторов допускается не ближе 5 мм от корпуса в течение не более 5 с. Температура пайки не должна превышать +260 °С. При этом необходимо обеспечить надежный теплоотвод между корпусом транзистора и местом пайки.